

Механизм протекания тока в омическом контакте Au–Ti–Al–Ti– n^+ -GaN в интервале температур 4.2–300 К

© А.В. Саченко⁺, А.Е. Беляев⁺, Н.С. Болтовец^{*}, Р.В. Конакова[†], Л.М. Капитанчук[‡],
В.Н. Шеремет⁺, Ю.Н. Свешников[#], А.С. Пилипчук[•]

⁺ Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева Национальной академии наук Украины,
03028 Киев, Украина

^{*} Государственное предприятие НИИ „Орион“,
03057 Киев, Украина

[‡] Институт электросварки им. Е.О. Патона Национальной академии наук Украины,
03068 Киев, Украина

[#] ЗАО „Элма-Малахит“,
124460 Зеленоград, Москва, Россия

[•] Институт физики Национальной академии наук Украины,
03028 Киев, Украина

(Получена 21 октября 2013 г. Принята к печати 28 ноября 2013 г.)

Экспериментально исследована и теоретически объяснена температурная зависимость удельного контактного сопротивления $\rho_c(T)$ омических контактов Au–Ti–Al–Ti– n^+ -GaN в диапазоне температур $T = 4.2–300$ К. Показано, что в низкотемпературной области измерений (4.2–50 К) наблюдается участок насыщения $\rho_c(T)$. С повышением температуры величина ρ_c уменьшается по экспоненциальному закону. Экспериментальная и расчетная зависимости $\rho_c(T)$ согласуются между собой. Полученные результаты позволяют сделать вывод о полевой природе токопереноса на участке насыщения $\rho_c(T)$ и термополевой — на экспоненциальном.

1. Введение

С момента начала разработок широкого класса полупроводниковых приборов, интегральных схем и их освоения в промышленном производстве изучению омических контактов уделялось не меньше внимания, чем получению и совершенствованию полупроводниковых материалов и структур [1–7]. Вплоть до настоящего времени, особенно в связи с использованием широкозонных полупроводников, например, нитридов элементов III группы и их твердых растворов, отмеченное внимание не ослабевает. Это обусловлено многообразием явлений в контактах и на границах раздела фаз, сложностью их расчетов и однозначной интерпретации. Оказалось, что температурные зависимости удельного контактного сопротивления омических контактов, $\rho_c(T)$, даже для такого основательно исследованного материала, как кремний, изучены не досконально, меньше информации или она совсем отсутствует о зависимости $\rho_c(T)$ для омических контактов к GaN, AlN, InN. Практически отсутствуют данные об особенностях температурной зависимости $\rho_c(T)$ в области температур $T < 80$ К. В то же время существует явная необходимость в такой информации для широкого круга специалистов, занимающихся как фундаментальными исследованиями нитридов элементов III группы и приборов на их основе в области низких температур (квантовый эффект Холла и эффект Шубникова–де-Гааза [8], физика электронного транспорта в полевых транзисторах терагерцового диапазона [9], магнитополевые эффекты в НЕМТ [10]), так и специалистов, использующих со-

ответствующих приборы в различных задачах прикладной криоэлектроники [11]. Для восполнения указанного недостатка в данной работе экспериментально исследована температурная зависимость $\rho_c(T)$ омических контактов Au–Ti–Al–Ti– n^+ -GaN в широком интервале температур, от 4.2 до 300 К. В простой модели выполнен расчет температурных зависимостей $\rho_c(T)$ для указанного контакта. Между экспериментальными и расчетными зависимостями получено достаточно хорошее согласие.

2. Образцы и методы исследования

Монокристаллические эпитаксиальные пленки $n^+–n–n^+–\text{GaN}$ на подложках Al_2O_3 были выращены в ЗАО „Элма-Малахит“ (г. Зеленоград, Россия) методом МОС-гидридной эпитаксии (metalorganic chemical vapor deposition, MOCVD). Параметры верхнего n^+ -слоя — концентрация $n^+ \approx 3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, толщина $d_{n^+} \approx 0.9 \text{ мкм}$, n -слоя — концентрация $n \approx 8 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$, толщина $d_n \approx 1.5 \text{ мкм}$, буферного слоя — концентрация $n^+ \approx 3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, толщина $d_{n^+} \approx 3 \text{ мкм}$. Толщина подложки Al_2O_3 была $\sim 400 \text{ мкм}$, плотность дислокаций $\gtrsim 10^8 \text{ см}^{-2}$.

Омические контакты создавались вакуумным напылением металлов Ti(30 нм)–Al(100 нм)–Ti(40 нм)–Au(100 нм) в одном технологическом цикле с быстрой термической обработкой (БТО) при температуре $T_a = 900^\circ\text{C}$ в течение 30 с.

До и после БТО на тестовых структурах, сформированных с помощью фотолитографии, измерялись вольт-амперные характеристики (ВАХ) и удельное контактное сопротивление ρ_c омических контактов. Зависимость

[†] E-mail: konakova@isp.kiev.ua

$\rho_c(T)$ омических контактов измерялась методом TLM (transmission line method) [12] на корпусированных образцах в диапазоне температур 4.2–300 К.

Стабилизация температуры обеспечивалась системой УТРЕКС К25в. Контроль температуры осуществлялся с помощью двух терморезистивных датчиков. Стабилизация для диапазона $T < 30$ К обеспечивалась на уровне не хуже 0.05 К, для диапазона 30–100 К — не хуже 0.1 К, для диапазона > 100 К — на уровне 0.5 К.

3. Морфологические особенности поверхности контактной металлизации до и после быстрой термической обработки

Исходный образец Au–Ti–Al–Ti–n⁺-GaN имеет достаточно однородную структуру верхнего слоя металлизации (пленка Au). После удаления ионным травлением всех слоев контактной металлизации наблюдается развитая ячеистая структура поверхности n-GaN. Профили

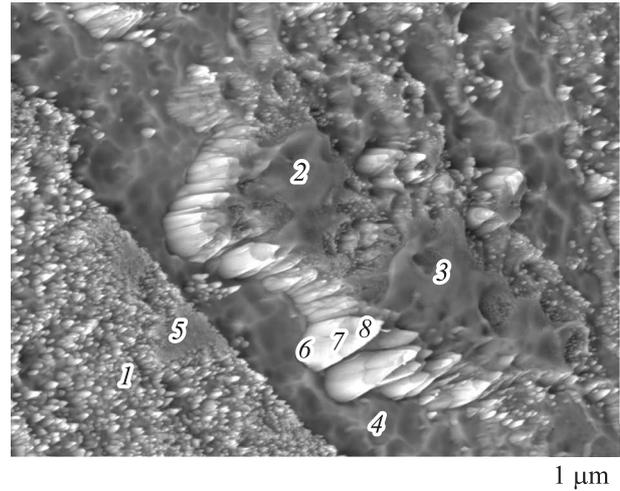


Рис. 2. Морфология поверхности границы раздела контактообразующий слой–GaN в контактной структуре Au–Ti–Al–Ti–n⁺-GaN после БТО при $T_a = 900^\circ\text{C}$.

распределения компонентов исходной контактной металлизации характеризуются слоистой структурой (рис. 1, a).

После БТО при $T_a = 900^\circ\text{C}$ в течение 30 с вся толщина контактной металлизации по данным спектроскопии (рис. 1, b) представляет собой сильно неоднородную область перемешивания компонентов металлизации и полупроводника. Особый интерес в этом случае представляет морфология поверхности границы раздела контактообразующий слой–GaN (рис. 2). Из приведенных на рис. 1, b и в таблице данных видно, сколь неоднородна поверхность полупроводника как по составу, так и по структуре. Наряду с участками 1, 4 (рис. 2), т.е. поверхностями, состоящими преимущественно из GaN, имеются области 2, 3, состоящие из конгломератов твердого раствора Al–Ti–Au, обогащенного Ga и содержащего до 15–23% азота, а также участки со столбчатой структурой переменного состава по высоте столбика (см. участки 6, 7, 8). Содержание металлической компоненты в таком столбике (Au, Al, Ti) на его острие возрастает на 1.5–2 порядка по сравнению с основанием. Судя по литературным данным

Элементный состав поверхности границы раздела контактообразующий слой–n⁺-GaN после БТО при $T_a = 900^\circ\text{C}$

| Образец | Концентрация, ат% | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | N | Al | Ti | Ga | Au |
| 1 | 48.51 | 0.04 | 0.00 | 51.38 | 0.07 |
| 2 | 23.44 | 8.36 | 13.07 | 47.84 | 7.29 |
| 3 | 15.51 | 14.85 | 16.42 | 40.44 | 12.78 |
| 4 | 48.92 | 0.00 | 0.38 | 50.63 | 0.06 |
| 5 | 45.26 | 1.83 | 4.77 | 46.81 | 1.33 |
| 6 | 48.45 | 0.28 | 0.08 | 50.99 | 0.19 |
| 7 | 47.15 | 0.92 | 3.46 | 47.61 | 0.86 |
| 8 | 14.59 | 37.33 | 4.51 | 16.05 | 27.52 |

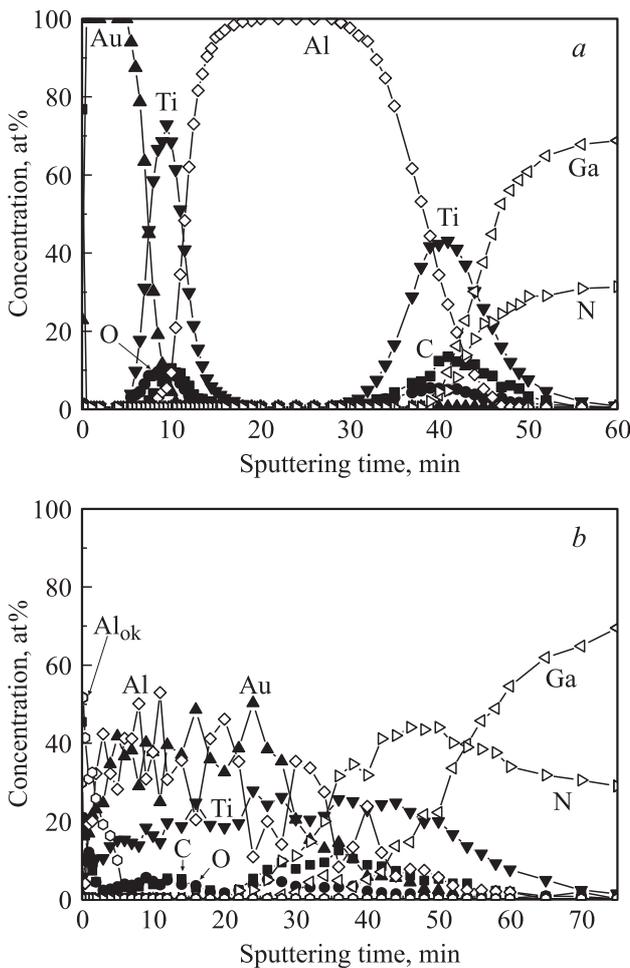


Рис. 1. Профили распределения компонентов контактной структуры Au–Ti–Al–Ti–n⁺-GaN до (a) и после БТО при $T_a = 900^\circ\text{C}$ (b). Al_{ок} — алюминий окисленный.

и технологическим разработкам, контакты к n -GaN на основе контактообразующей композиции Ti/Al с описанной выше морфологией поверхности границы раздела металл–GaN являются типичными [2–4,13,14] и существенно влияют на проведение дальнейших технологических процессов (например, фотолитографии, сборки активных элементов в корпус).

4. Электрические характеристики омических контактов Au–Ti–Al–Ti– n^+ -GaN

Вольт-амперные характеристики исходных контактных структур были линейными. Удельное контактное сопротивление таких структур было $\lesssim 0.7 \text{ Ом} \cdot \text{см}^2$. После БТО во всем измеряемом диапазоне температур ВАХ были линейными, а ρ_c при комнатной температуре составляло $\sim (2-3) \cdot 10^{-4} \text{ Ом} \cdot \text{см}^2$. На рис. 3 приведена зависимость $\rho_c(T)$ для исследуемых омических контактов. Как видно из рис. 3, при $T \leq 50 \text{ К}$ зависимость $\rho_c(T)$ практически насыщается (ρ_c не зависит от температуры), что характерно для полевого механизма токопрохождения. Этот механизм обеспечивается сильным вырождением полупроводника в приконтактной области, а также чисто туннельным прохождением электронов через барьер. При $T > 50 \text{ К}$ $\rho_c(T)$ убывает с ростом температуры. Перестроив зависимость $\rho_c(T)$ в координатах $\rho_c = f(10^3/T)$, легко убедиться в том, что при $T > 70 \text{ К}$ зависимость $\rho_c(T)$ является экспоненциальной. В этом случае токопрохождение определяется термополевым механизмом.

5. Обсуждение результатов эксперимента

Проанализируем полученные экспериментальные зависимости $\rho_c(T)$. Туннельный ток в окрестности $T = 0 \text{ К}$

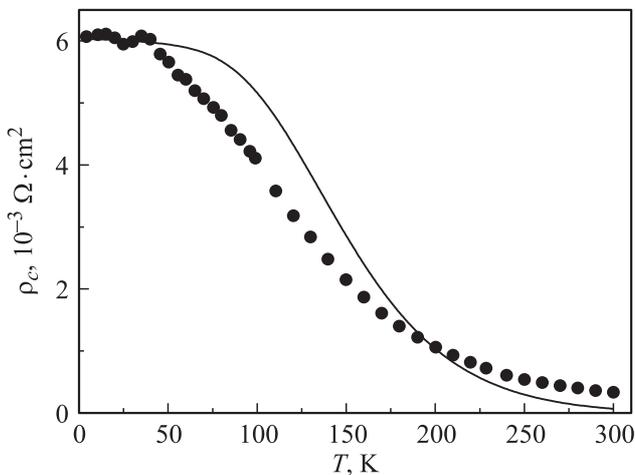


Рис. 3. Зависимость $\rho_c(T)$ для омических контактов Au–Ti–Al–Ti– n^+ -GaN: точки — эксперимент, сплошная линия — расчет по формуле (3).

описывается выражением, полученным в работе Падовани и Стреттона [15]. Отметим, что при $T = 0$ плотность туннельного тока J_{FE} можно записать в следующем виде:

$$J_{FE} = qN_dV_{T0} \left[\exp\left(-\frac{\varphi_b - E_{f \text{ lim}} - qV}{E_{00}}\right) - \exp\left(-\frac{\varphi_b - E_{f \text{ lim}}}{E_{00}}\right) \right], \quad (1)$$

где q — элементарный заряд, N_d — концентрация электронов, равная концентрации мелких доноров, $V_{T0} = q^2/h\varepsilon_0\varepsilon_s\kappa^2$ — скорость прохождения электронов через контакт, $\kappa = \lg[4(\varphi_b - E_{f \text{ lim}})/E_{f \text{ lim}}]$ — коэффициент порядка 1, $E_{f \text{ lim}} = (3\pi^2)^{2/3}\hbar^2N_d^{2/3}/2m_n^*$ — предельная энергия Ферми для сильно вырожденного полупроводника [16], $E_{00} = 0.054[(m_0/m^*)(N_d/10^{20})(11.7/\varepsilon_s)]^{0.5}$ — характеристическая энергия туннелирования (в эВ), m_n^* — эффективная масса электрона, \hbar (h) — постоянная Планка, φ_b — потенциальная энергия электрона, т.е. высота барьера (в эВ), V — приложенное напряжение, ε_s — диэлектрическая проницаемость полупроводника, ε_0 — диэлектрическая проницаемость вакуума.

Обобщим выражение для тока, протекающего через контакт с вырожденным полупроводником, на случай $T \neq 0$. Сделаем это, заменив выражение для E_{00} на $E_0 = E_{00} \text{cth}(E_{00}/kT)$ (k — постоянная Больцмана), что, согласно [17], позволяет описать участок термополевой эмиссии. Учтем также зависимость скорости прохождения электронов через контакт (V_T) и энергии Ферми (E_f) от температуры, используя общее выражение для тока полевой эмиссии, приведенное в [15]. В результате для плотности тока получим

$$J_F^*(T) = qN_dV_T(T) \left[\exp\left(-\frac{\varphi_b - E_f(T) - qV}{E_0(T)}\right) - \exp\left(-\frac{\varphi_b - E_f(T)}{E_0(T)}\right) \right], \quad (2)$$

где $V_T(T) = 2\pi A(m_n^*/m_0)TE_{00}/[\kappa k \sin(\kappa\pi kT/2E_{00})qN_d]$, A — постоянная Ричардсона.

При $T = 0$ выражение (2) переходит в (1), однако при $T \neq 0$ оно отличается от выражения для туннельного тока, приведенного в [15]. Отличие заключается в том, что в работе Падовани–Стреттона [15] вместо $E_0(T)$ фигурирует E_{00} . В случае, когда полупроводник сильно вырожден как при низких, так и при высоких температурах, имеет место достаточно хорошее равенство $E_0(T) \approx E_{00}$. Однако для не сильно вырожденных полупроводников в области достаточно высоких температур $E_0(T) < E_{00}$, и это приводит к тому, что экспоненциальные члены, в согласии с [17], совпадают с таковыми для случая термополевой эмиссии.

Выражение для контактного удельного сопротивления $\rho_c(T)$ получается дифференцированием плотности тока (2) по приложенному смещению и после дифференцирования принимает вид

$$\rho_c(T) = \frac{E_0(T)}{q^2N_dV_T(T)} \left[\exp\left(\frac{\varphi_b - E_f(T)}{E_0(T)}\right) \right]. \quad (3)$$

Температурная зависимость $E_f(T)$ находится из уравнения электрической нейтральности полупроводника вида

$$N_d = n = \frac{2}{\sqrt{\pi}} N_c \left(\frac{T}{300} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{x^{0.5}}{1 + \exp(x - \varepsilon_f)} dx, \quad (4)$$

где N_c — эффективная плотность состояний в зоне проводимости при $T = 300$ К, $\varepsilon_f(T) = E_f(T)/kT$,

Теоретическая кривая на рис. 3 построена с использованием формулы (3). Как видно из рисунка, согласие между экспериментальной и теоретической зависимостями достаточно хорошее. В области температур от 4.2 до 40 К величина ρ_c постоянна, а при $T \leq 65$ К $E_0 \approx E_{00}$. При $T > 65$ К начинается более сильный спад теоретической кривой для $\rho_c(T)$, и этот участок соответствует термополевой эмиссии. Особенностью теоретической кривой является то, что для ее реализации нужен всего один параметр (φ_b), равный 0.36 эВ.

6. Заключение

Несмотря на сравнительно высокую неоднородность границы раздела контактообразующий слой–n⁺-GaN, омичность контактов Au–Ti–Al–Ti–n⁺-GaN сохраняется во всем диапазоне температур измерения 4.2–300 К. Полученные экспериментальные результаты и их теоретическая обработка свидетельствуют о полевой природе токопрохождения на участке насыщения $\rho_c(T)$ в области температур 4.2–50 К для омических контактов к GaN с вырожденным n⁺-слоем в приконтактной области полупроводника и термополевой в области температур от 50 до 300 К.

Список литературы

- [1] *Ohmic Contacts to Semiconductor*, ed. by B. Schwartz (Electrochem Soc. Inc., 1969).
- [2] Т.В. Бланк, Ю.А. Гольдберг. ФТП, **41** (11), 1281 (2007).
- [3] R. Quay. *Gallium Nitride Electronics* (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2008).
- [4] А.Г. Васильев, Ю.В. Колковский, Ю.А. Концевой. *СВЧ транзисторы на широкозонных полупроводниках* (М., Техносфера, 2011).
- [5] М.Г. Мильвидский, В.Б. Освенский. *Структурные дефекты в эпитаксиальных слоях полупроводниковых приборов* (М., Металлургия, 1985).
- [6] А.Н. Ковалев. *Транзисторы на основе полупроводниковых гетероструктур* (М., Изд. дом МИСиС, 2011).
- [7] К.Л. Ерншерлова, А.В. Лютцау, Л.Ф. Сейдман, Э.М. Темпер, А.М. Коновалов, В.В. Пицагин. В сб.: *Нитриды галлия, индия и алюминия — структуры и приборы. Тез. докл. 9-й Всеросс. конф.* (М.–СПб., 2013) с 273.
- [8] W. Knap, S. Contreras, H. Alause, S. Skierbiszewski, J. Camassel, M. Dyakonov, J.L. Robert, J. Yang, Q. Chen, M. Asif Khan, M.L. Sadowski, S. Huant, F.H. Yang, M. Goiran, J. Leotin, M.S. Shur. *Appl. Phys. Lett.*, **70** (16), 2123 (1997).

- [9] O.A. Klimenko, W. Knap, B. Iniguez, D. Coquillat, Y.A. Mityagin, F. Teppe, N. Dyakonova, H. Videliel, D. But, F. Lime, J. Marczewski, K. Kucharski. *J. Appl. Phys.*, **112** (1), 014506 (2012).
- [10] R. Taurk, J. Lusakowski, W. Knap, A. Tiberj, Z. Bougrioua, M. Azize, P. Lorenzini, M. Sakowicz, K. Karpierz, C. Fenouillet-Beranger, M. Casse, C. Gallon, F. Boeuf, T. Skotnicki. *J. Appl. Phys.*, **102** (10), 103701 (2007).
- [11] В.Н. Алфеев, П.А. Бахтин, А.А. Васенков, И.Д. Войтович, В.И. Махов. *Интегральные схемы и микроэлектронные устройства на сверхпроводниках* (М., Радио и связь, 1985).
- [12] D.K. Schroder. *Semiconductor Material and Device Characterisation* (Wiley, New Jersey, 2006).
- [13] S. Noor Mohammad. *J. Appl. Phys.*, **95** (12), 7970 (2004).
- [14] S. Fernández, R. Peña, M.T. Rodrigo, J. Plaza, M. Verdú, F.J. Sánchez, M.T. Montojo. *Appl. Phys. Lett.*, **90** (8), 083504 (2007).
- [15] F.A. Padovani, R. Stratton. *Sol. St. Electron.*, **9** (7), 695 (1966).
- [16] А.И. Ансельм. *Введение в теорию полупроводников* (СПб., Лань, 2008).
- [17] *Contacts to Semiconductors. Fundamentals and Technology*, ed. by L.J. Brillson (Noyes Publications, Park Ridge, New Jersey, USA, 1993) p. 29.

Редактор Л.В. Шаронова

Mechanism of current in the 4.2–400 K temperature range for Au–Ti–Al–Ti–n⁺-GaN ohmic contact

A.V. Sachenko⁺, A.E. Belyaev⁺, N.S. Boltovets^{*}, R.V. Konakova[†], L.M. Kapitanchuk[‡], V.N. Sheremet⁺, Yu.N. Sveshnikov[#], A.S. Pilipchuk[•]

⁺ V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, 03028 Kyiv, Ukraine

^{*} State Enterprise Research Institute „Orion“, 03057 Kyiv, Ukraine

[‡] Paton Electric Welding Institute, National Academy of Sciences of Ukraine, 03068 Kyiv, Ukraine

[#] Close Corporation „Elma-Malachite“, 124460 Zelenograd, Moscow, Russia

[•] Institute of Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, 03028 Kyiv, Ukraine

Abstract We studied experimentally and explained theoretically the temperature dependence of contact resistivity, $\rho_c(T)$, in the 4.2–300 K temperature range for Au–Ti–Al–Ti–n⁺-GaN ohmic contacts. It is shown that the $\rho_c(T)$ curve flattens out in the low-temperature part (4.2–50 K) of the temperature range. As temperature grows, the contact resistivity ρ_c decreases exponentially. The calculated and experimental dependences $\rho_c(T)$ agree each with other. The results obtained enable one to draw a conclusion on field nature of current flow mechanism at the saturation part of $\rho_c(T)$ curve and thermal field mechanism at the exponential part.